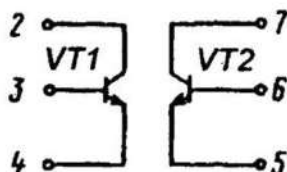


К159НТ1А — К159НТ1Е, КР159НТ1А — КР159НТ1Е

Микросхемы представляют собой матрицу из двух *n-p-n* транзисторов (для построения дифференциальных усилителей). Корпус типа 301.8-2, масса не более 1,3 г и типа 201 14-1, масса не более 1 г.



Электрическая схема К159НТ1, КР159НТ1

Назначение выводов. 1, 8 — свободные; 2 — коллектор транзистора *VT1*; 3 — база транзистора *VT1*; 4 — эмиттер транзистора *VT1*; 5 — эмиттер транзистора *VT2*; 6 — база транзистора *VT2*; 7 — коллектор транзистора *VT2*

Электрические параметры

Разность напряжений эмиттер-база транзисторов:

К159НТ1А, КР159НТ1А, К159НТ1Б, КР159НТ1Б, К159НТ1В, КР159НТ1В . . .	< 3 мВ
К159НТ1Г, КР159НТ1Г, К159НТ1Д, КР159НТ1Д, К159НТ1Е, КР159НТ1Е . . .	< 15 мВ

Прямое падение напряжения между эмиттером и базой ($I_b = 1\text{ мА}$)	0,55...0,75 В
Обратный ток коллектор-база	< 200 нА
Обратный ток эмиттер-база	< 500 нА
Ток утечки между транзисторами <i>VT1</i> и <i>VT2</i> при $U = 20\text{ В}$	< 20 нА

Коэффициент усиления по току (при $U_{кб} = 5В$,
 $I_0 = 1 мА$):

К159НТ1А, КР159НТ1А, К159НТ1Г, КР159НТ1Г	20.. 80
К159НТ1Б, КР159НТ1Б, К159НТ1Д, КР159НТ1Д	60 .. 180
К159НТ1В, КР159НТ1В, К159НТ1Е, КР159НТ1Е	> 80
Емкость коллектора на частоте 10 МГц	< 4 пФ
Емкость эмиттера на частоте 10 кГц .	< 5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-база	20 В
Напряжение эмиттер-база	4 В
Напряжение между транзисторами .	20 В
Ток коллектора постоянный	10 мА
Ток коллектора импульсный ($t_m = 30мкс$)	40 мА
Рассеиваемая мощность (при $T = - 60...+ 70^{\circ} С$)	50 мВт